

日立 **25C1343** はシリコンNPN三重拡散形トランジスターで、60~100W HiFi OTL アンプの出力用に設計されたものです。またこのトランジスターはシリコンPNPトランジスター **25A753** とコンプリメンタリペアになっており、100W純コンプリメンタリアンプが作製できます。

最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

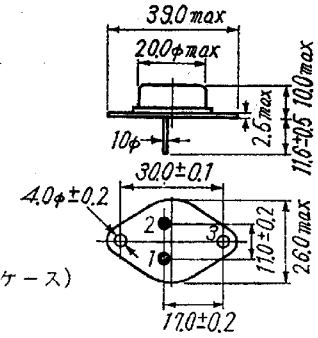
項目	記号	25C1343	単位
コレクター・ベース電圧	V_{CB0}	150	V
コレクター・エミッター電圧	V_{CE0}	110	V
エミッター・ベース電圧	V_{EB0}	5	V
コレクター電流	I_C	10	A
せん頭コレクター電流	$I_{C(\text{peak})}$	12	A
ベース電流	I_B	2	A
許容コレクター損失*	P_C	100	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{sig}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

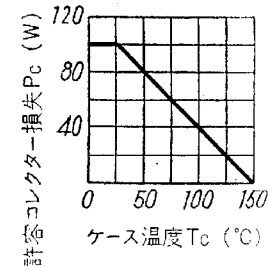
電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	記号	測定条件	最小値	標準値	最大値	単位
コレクター・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CB0}$	$I_C=5\text{mA}, I_E=0$	150	—	—	V
コレクター・エミッター破壊電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_C=50\text{mA}, R_{BE}=\infty$	110	—	—	V
エミッター・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E=5\text{mA}, I_C=0$	5	—	—	V
コレクター遮断電流	I_{CB0}	$V_{CB}=30\text{V}, I_E=0$	—	—	1	mA
コレクター・エミッター飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=5\text{A}, I_B=1\text{A}$	—	0.4	1.5	V
直流電流増幅率*	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$	30	100	200	
		$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{A}$	15	—	—	
ベース・エミッター電圧	V_{BE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$	—	0.75	1.5	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$	8	14	—	MHz
2次破壊電流	I_M	$V_{CE}=70\text{V}, f=50\text{Hz}$ 半波	5	—	—	A

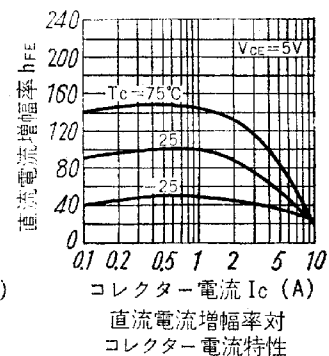
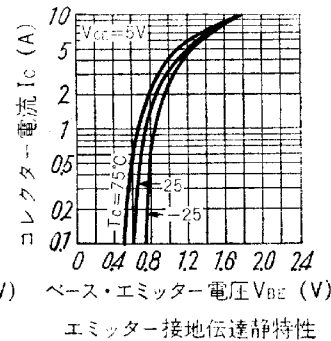
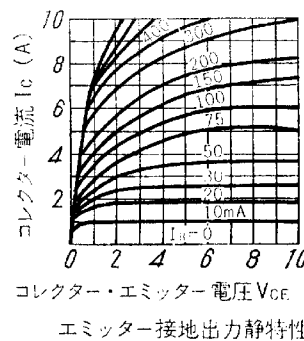
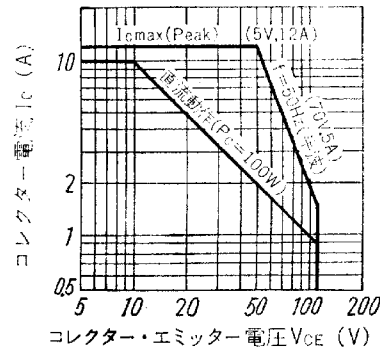
* **25C1343** は h_{FE} の値により下記のように3区分し、現品にそれぞれ (A), (B), (C) と表示してあります。(A) 30~60, (B) 50~120, (C) 100~200



1. ベース
 2. エミッター
 3. コレクター(ケース)
- 単位: mm



許容コレクター損失の
ケース温度による変化



[第5図] 25C1343 (日立) パワー Tr の規格